Wolfgang Menz, Jürgen Mohr, Oliver Paul

Mikrosystemtechnik für Ingenieure

Dritte, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage



WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhalt

٧.	rwort	VV
VO	rwort	XV

1	Allgemeine Einführung in die Mikrostrukturtechnik 1
1.1	Was ist Mikrostrukturtechnik? 1
1.2	Von der Mikrostrukturtechnik zur Mikrosystemtechnik 9
2	Parallelen zur Mikroelektronik 15
2.1	Herstellung von Einkristallscheiben 15
2.1.1	Herstellung von Silizium-Einkristallen 17
2.1.1.1	Tiegelziehverfahren (Czochralski-Verfahren) 19
2.1.1.2	Zonenziehverfahren (Float-Zone-Verfahren) 21
2.1.1.3	Segregation 23
2.1.1.4	Weiterverarbeitung der Ingots 25
2.1.2	Herstellung von GaAs-Einkristallen 28
2.1.2.1	Bridgman- und Gradient-Freeze-Verfahren 28
2.1.2.2	LEC-Verfahren (Liquid Encapsulated Czochralski) 30
2.2	Technologische Grundprozesse 31
2.2.1	Herstellung eines integrierten Schaltkreises 33
2.2.1.1	Reinigung 33
2.2.1.2	Oxidation 34
2.2.1.3	Photolithographie 34
2.2.1.4	Ionenimplantation und Diffusion 35
2.2.1.5	Ätzen 35
2.2.1.6	Beschichtung 36
2.3	Weiterverarbeitung der integrierten Schaltungen 36
2.3.1	Anforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik 37
2.3.2	Hybridtechniken 38
2.3.2.1	Dickschichttechnik 38
2.3.2.2	Bestücken und Löten der Schaltung 39
2.3.2.3	Montage und Kontaktierung ungehäuster Halbleiterbauelemente 40
2.4	Reinraumtechnik 41
2. 4.1	Partikelmessung im Reinraum 45
2.5	Punktfehler und Ausbeute bei Halbleiterbauelementen 45

Mikratystemtechnik für Ingenieure, 3. Auflage. W. Menz, J. Mohr, O. Paul Copyright © 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-30536-X

۷ı	Inhalt	
·	3	Physikalische und chemische Grundlagen der Mikrotechnik 49
	3.1	Kristalle und Kristallographie 49
	3.1.1	Gitter und Gittertypen 50
	3.1.2	Stereographische Projektion 52
	3.1.3	Silizium-Einkristall 56
	3.1.4	Reziprokes Gitter und Kristallstrukturanalyse 58
	3.2	Methoden zur Bestimmung der Kristallstruktur 65
	3.2.1	Röntgenstrahlbeugung 65
	3.2.2	Elektronenstrahlbeugung 67
	3.3	Grundlagen der galvanischen Abscheidung 69
	3.3.1	Phasengrenze Elektrode-Elektrolyt 72
	3.3.1.1	Elektrisches und elektrochemisches Potential 72
	3.3.2	Polarisation und Überspannung 75
	3.3.3	Mechanismen der kathodischen Metallabscheidung 77
	3.3.3.1	Migration 79
	3.3.3.2	Diffusion 80
	3.3.3.3	Konvektion 80
	3.3.3.4	Stofftransportvorgänge während der Mikrogalvanoformung 83
	3.4	Grundlagen der Vakuumtechnik 84
	3.4.1	Mittlere freie Weglänge 84
	3.4.2	Wiederbedeckungszeit 86
	3.4.3	Geschwindigkeit von Atomen und Molekülen 87
	3.4.4	Gasdynamik 89
	3.4.5	Einteilung des technischen Vakuums 89
	3.5	Vakuumerzeugung 91
	3.5.1	Pumpen für Grob- und Feinvakuum 91
	3.5.1.1	Verdrängervakuumpumpen 91
	3.5.2	Hochvakuum- und Ultrahochvakuumpumpen 93
	3.5.2.1	Treibmittelvakuumpumpen 95
	3.5.2.2	Gas bindende Vakuumpumpen (Sorptionspumpen) 96
	3.6	Vakuummessung 99
	3.6.1	Druckmessdose 99
	3.6.2	Wärmeleitungsvakuummeter 99
	3.6.3	Reibungsvakuummeter 100
	3.6.4	Ionisationsvakuummeter mit unselbständiger Entladung
		(Glühkathode) 100
	3.6.5	Ionisationsvakuummeter mit selbständiger Entladung
		(Penning-Prinzip) 101
	3.6.6	Leckage und Lecksuche 102
	3.7	Eigenschaften von Dünnschichten 103
	3.7.1	Strukturzonenmodelle 103
	3.7.2	Haftfestigkeit der Schicht 106

4	Materialien der Mikrosystemtechnik 109
4.1	Materialeigenschaften 111
4.1.1	Thermische Eigenschaften 112
4.1.1.1	Wärmeleitfähigkeit 113
4.1.1.2	Spezifische Wärme 113
4.1.1.3	Latente Wärme 114
4.1.1.4	Wärmeausdehnungskoeffizient 114
4.1.2	Elektrische Eigenschaften 115
4.1.2.1	Elektrische Leitfähigkeit 115
4.1.2.2	Dielektrische Konstante 116
4.1.2.3	Thermoelektrizität 116
4.1.2.4	Piezoresistivität 117
4.1.3	Mechanische Eigenschaften 119
4.2	Kunststoffe 120
4.2.1	Ordnung der Makromoleküle 121
4.2.2	Polymere für die Lithographie 122
4.2.3	Flüssigkristalle 124
4.2.4	Flüssigkristalline Polymere 125
4.2.5	Gele 127
4.2.6	Elektrorheologische Flüssigkeiten 129
4.3	Halbleiter 131
4.4	Keramiken 134
4.4.1	Keramik als Substrat 134
4.4.2	Keramik als Material für Aktoren 135
4.4.3	Keramik als Material für Gassensoren 135
4.5	Metalle 136
4.5.1	Magnetostriktive Metalle 137
4.5.2	Anwendungen der Magnetostriktion 139
4.5.3	Formgedächtnis-Legierungen 140
4.5.3.1	Einwegeffekt 141
4.5.3.2	Zweiwegeffekt 142
4.5.3.3	Unterdrücktes Formgedächtnis 143
4.5.3.4	Einsatz als Aktoren 144
4.5.3.5	Herstellung 144
4.5.3.6	Eigenschaften der Formgedächtnislegierungen 145
5	Basistechnologien der Mikrotechnik 147
5.1	Schichtabscheidung 147
5.1.1	Physikalische Beschichtungstechniken 147
5.1.1.1	Aufdampfen 147
5.1.1.2	Sputtern (Kathodenzerstäuben) 151
5.1.1.3	Ionenplattieren 153
5.1.2	Chemische Beschichtungstechniken 154
5.1.2.1	CVD-Verfahren 154
5.1.2.2	Epitaxie 160

111	Inhalt	
'	5.1.2.3	GaAs-Epitaxie 163
	5.1.2.4	Plasmapolymerisation 163
	5.2	Schichtmodifikation 164
	5.2.1	Thermische Oxidation 164
	5.2.2	Diffusion 165
	5.2.3	Ionenimplantation 167
	5.3	Schichtabtragung (Ätzen) 168
	5.3.1	Physikalische und chemische Trockenätzverfahren 170
	5.3.1.1	Plasmaquellen 172
	5.3.1.2	Charakteristika der rein physikalischen Ätzprozesse 173
	5.3.1.3	Kombination chemischer und physikalischer Ätzprozesse 178
	5.3.1.4	Charakteristika des reaktiven Ionen- und Ionenstrahlätzens 180
	5.3.1.5	Das rein chemische Ätzen 181
	5.4	Analyse von Dünnschichten und Oberflächen 184
	5.4.1	Elektronenstrahl-Mikroanalyse (Electron Probe Microanalysis, EPM) 185
	5.4.2	Auger-Elektronenspektroskopie (AES) 186
	5.4.3	Photoelektronenspektroskopie (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA) 187
	5.4.4	Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) 188
	5.4.5	Sekundär-Neutralteilchen-Massenspektrometrie (SNMS) 188
	5.4.6	Ionen-Streuspektroskopie (ISS) 189
	5.4.7	Rutherford-Rückstreuungsspektroskopie (Rutherford Backscattering Spectroscopy, RBS) 189
	5.4.8	Rastertunnelmikroskop (Atomic Force Microscope, AFM) 190
	6	Lithographie 191
	6.1	Überblick und Historie 191
	6.2	Resists 196
	6.3	Verfahren der Lithographie 198
	6.3.1	Computer Aided Design (CAD) 199
	6.3.1.1	CAD-Entwurf 200
	6.3.1.2	Justiermarken und Teststrukturen 202
	6.3.1.3	Organisation des Entwurfs (Hierarchie, Layers) 203
	6.4	Elektronenstrahllithographie 205
	6.4.1	Gauß'scher Strahl 206
	6.4.2	Geformter Strahl 211
	6.4.3	Postprozessor 213
	6.5	Proximity-Effekt 214
	6.6	Optische Lithographie 216
	6.6.1	Masken 217
	6.6.2	Schattenprojektion 218
	6.6.3	Abbildende Projektion 221
	6.6.3.1	Ganzscheiben-Belichtung 222
	6.6.3.2	Moderne Lithographiemaschinen 223

6.7	Weiterentwicklungen 224
6.7.1	Phasenmasken 224
6.7.2	Spezielle Resisttechnologien 225
6.7.3	Optische Lithographie für die Mikrostrukturtechnik 226
6.8	Ionenstrahllithographie 231
6.9	Röntgenlithographie 232
6.9.1	Masken für die Röntgenlithographie 233
6.9.2	Röntgenlichtquellen 234
6.9.3	Synchrotronstrahlung 235
6.9.4	Einsatz der Röntgenlithographie 240
7	Silizium-Mikromechanik 241
7.1	Siliziumtechnologie 242
7.1.1	IC-Prozesse und -Substrate 243
7.1.2	Foundry-Technologien 247
7.2	Silizium-Bulk-Mikromechanik 248
7.2.1	Einleitung 248
7.2.1.1	Ätzrate und Anisotropie 250
7.2.1.2	Selektivität 251
7.2.1.3	Prozesskompatibilität 251
7.2.1.3	Einfachheit der Verwendung und Sicherheit 252
7.2.1.7	Kosten 253
7.2.1.3	Nasschemisches Ätzen 253
7.2.2.1	HNA-Ätzlösungen 253
7.2.2.2	Alkalihydroxid-Ätzlösungen 255
7.2.2.3	Ammoniumhydroxid-Ätzlösungen 259
7.2.2.4	Ethylendiamin-Brenzkatechin-Ätzlösungen 260
7.2.3	Grundlegende Ätzformen 261
7.2.3.1	Ätzgruben und -gräben 262
7.2.3.2	Membranen 264
7.2.3.3	Mesas und Spitzen 264
7.2.3.4	Cantilever 265
7.2.3.5	Brücken 267
7.2.4	Ätzkontrolle 268
7.2.4.1	Ätzstoppmechanismen 268
7.2.4.2	Elektrochemisches Siliziumätzen 271
7.2.4.3	Elektrochemische Siliziumporosifizierung 273
7.2.5	Charakterisierung von anisotropen Nassätzmitteln 274
7.2.6	Trockenätzen 276
7.2.6.1	XeF ₂ -Ätzen 276
7.2.6.1	Fertigung von Mikrostrukturen mit hohem Aspektverhältnis 279
7.2.6.2	Anwendungen von trockenem Siliziumätzen 281
7.2.6.3	Oberflächenmikromechanik 285
	Polysilizium-Mikromechanik 287
7.3.1	Opferaluminium-Mikromechanik 290
7.3.2	Opicialummum-wirkiomecualiik 270

, A

×Ι	Inhalt	
'	7.3.3	Opferpolymer-Mikromechanik 292
	7.3.4	Sticking 293
	7.4	Mikrowandler und -systeme in der Siliziumtechnologie 294
	7.4.1	Mechanische Bauteile und Systeme 295
	7.4.1.1	Drucksensoren 296
	7.4.1.2	Beschleunigungssensoren 298
	7.4.1.3	Drehratensensoren 300
	7.4.1.4	Stresssensoren 302
	7.4.2	Thermische Mikrobauteile und -systeme 304
	7.4.2.1	Temperaturmessung 304
	7.4.2.2	Durchflusssensoren 308
	7.4.2.3	Vakuum- und Drucksensoren 311
	7.4.3	Komponenten und Systeme für Strahlungssignale 313
	7.4.3.1	Ungekühlte Infrarotdetektoren 313
	7.4.3.2	Thermische Szenensimulatoren 316
	7.4.3.3	Lichtschalter 316
	7.4.4	Magnetische Bauteile und Systeme 319
	7.4.5	Chemische Mikrosensoren 321
	7.4.5.1	Mikrofluidische Komponenten und Systeme 324
	7.4.6	Mikromechanische Bauteile für die Signalverarbeitung 326
	7.5	Zusammenfassung und Ausblick 328
	8	LIGA-Verfahren 329
	8 8.1	LIGA-Verfahren 329 Überblick 329
	8.1	Überblick 329
	8.1 8.2	Überblick 329 Maskenherstellung 331
	8.1 8.2 8.2.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341 Herstellung von dicken Resistschichten 341
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1 8.3.1.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341 Herstellung von dicken Resistschichten 341 Strahleninduzierte Reaktionen und Entwicklung des Resists 343
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1 8.3.1.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341 Herstellung von dicken Resistschichten 341 Strahleninduzierte Reaktionen und Entwicklung des Resists 343 Anforderungen an die absorbierte Strahlendosis 347
	8.1 8.2 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.2 8.3.3	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341 Herstellung von dicken Resistschichten 341 Strahleninduzierte Reaktionen und Entwicklung des Resists 343 Anforderungen an die absorbierte Strahlendosis 347 Einflüsse auf die Strukturqualität 350
	8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 8.3.1 8.3.1.1	Überblick 329 Maskenherstellung 331 Prinzipieller Aufbau einer Maske 331 Absorber 331 Trägerfolie 332 Herstellung der Trägerfolien 334 Strukturierung des Resists für Röntgenzwischenmasken 335 Optische Lithographie 335 Direkte Elektronenstrahllithographie 336 Reaktives Ionenätzen 337 Vergleich der Strukturierungsmethoden zur Herstellung von Zwischenmasken 337 Goldgalvanik für Röntgenmasken 337 Herstellung von Arbeitsmasken 339 Justieröffnungen in Röntgenarbeitsmasken 340 Röntgentiefenlithographie 341 Herstellung von dicken Resistschichten 341 Strahleninduzierte Reaktionen und Entwicklung des Resists 343 Anforderungen an die absorbierte Strahlendosis 347

8.3.3.3	Neigung der Absorberwände zum Strahl 354
8.3.3.4	Fluoreszenzstrahlung aus der Maskenmembran 354
8.3.3.5	Erzeugung von Sekundärelektronen aus der Haft- und
	Galvanikstartschicht 354
8.3.3.6	Quellen des Resists 356
8.4	Galvanische Abscheidung 356
8.4.1	Galvanische Abscheidung von Nickel für die Mikrostruktur- herstellung 357
8.4.2	Formeinsatzherstellung für die Mikroabformung 361
8.4.3	Galvanische Abscheidung weiterer Metalle und Legierungen 362
8.5	Kunststoffabformung im LIGA-Verfahren 364
8.5.1	Herstellung von Mikrostrukturen im Reaktionsgießverfahren 365
8.5.2	Herstellung von Mikrostrukturen im Spritzgießverfahren 368
8.5.3	Herstellung von Mikrostrukturen im Heißprägeverfahren 374
8.5.4	Herstellung von metallischen Mikrostrukturen aus abgeformten
	Kunststoffstrukturen (zweite Galvanoformung) 377
8.5.4.1	Zweite Galvanoformung geprägter Mikrostrukturen 377
8.5.4.2	Zweite Galvanoformung mit Hilfe einer metallischen
	Angussplatte 377
8.5.4.3	Zweite Galvanoformung mit Hilfe elektrisch leitfähiger
	Kunststoffe 379
8.5.4.4	Zweite Galvanoformung durch Beschichtung der Kunststoff-
	strukturen 381
8.6	Variationen und ergänzende Schritte des LIGA-Verfahrens 382
8.6.1	Opferschichttechnik 382
8.6.2	3D-Strukturierung 385
8.6.2.1	Gestufte Strukturen 385
8.6.2.2	Geneigte Strukturen 387
8.6.2.3	Konische Strukturen und Strukturen mit sphärischer
	Oberfläche 388
8.6.2.4	Herstellung von Strukturen mit beweglicher Maske 389
8.6.3	Herstellung Licht leitender Strukturen durch Abformung 391
8.7	Protonenlithographie (DLP) – ein weiteres Strukturierungsverfahren
	zur Herstellung von Mikrostrukturen mit großem Aspekt-
	verhältnis 394
8.8	Anwendungsbeispiele 399
8.8.1	Starre metallische Mikrostrukturen 400
8.8.1.1	Filter für das Ferne Infrarot 400
8.8.1.2	Mikrospulen 401
8.8.1.3	Mikrozahnräder, Mikrogetriebe 403
8.8.2	Bewegliche Mikrostrukturen, Mikrosensoren, Mikroaktoren 403
8.8.2.1	Beschleunigungssensoren 404
8.8.2.2	Elektrostatischer Linearantrieb 406
8.8.2.3	Elektromagnetischer Linearaktor 407
8.8.2.4	Mikroturbine, Strömungssensoren, Mikrofräser 412

ХII	Inhalt	
'	8.8.2.5	Mikromotoren 413
	8.8.3	Fluidische Mikrostrukturen 416
	8.8.3.1	Mikrostrukturierte Fluidplatten 416
	8.8.3.2	Mikropumpen nach dem LIGA-Verfahren 416
	8.8.3.3	Mikrofluidische Schalter 416
	8.8.3.4	Mikrofluidische Linearaktoren 418
	8.8.4	LIGA-Strukturen für optische Anwendungen 419
	8.8.4.1	Einfache optische Elemente – Linsen, Prismen 420
	8.8.4.2	Mikrooptische Bank 422
	8.8.4.3	Mikrooptische Bänke mit Aktoren 426
	8.8.4.4	Funktionsmodule mit optisch aktiven Elementen –
	0.0.7.7	modulares Aufbaukonzept 429
		modulates narbadkonzept 425
	9	Alternative Verfahren der Mikrostrukturierung 437
	9.1	Ultrapräzisionsmikrobearbeitung 438
	9.1.1	Anwendungsbeispiele 443
	9.1.1.1	Mikrowärmeüberträger 443
	9.1.1.2	Mikroreaktoren 445
	9.1.1.3	Retrospiegel 446
	9.1.1.4	Mikropumpen 447
	9.2	Mikrofunkenerosion (von R. Förster) 448
	9.2.1	Physikalisches Prinzip 448
	9.2.1.1	Aufbauphase 450
	9.2.1.2	Entladephase 451
	9.2.1.3	Abbauphase 451
	9.2.2	Funkenerosive Bearbeitung keramischer Werkstoffe 452
	9.2.2.1	Siliziuminfiltriertes Siliziumcarbid (SiSiC) 453
	9.2.2.2	Siliziumnitrid (Si ₃ N ₄) 454
	9.2.2.3	Elektrisch nicht leitfähige Keramiken 454
	9.2.3	Verfahrensvarianten 455
	9.2.3.1	Funkenerosives Senken 455
	9.2.3.2	Funkenerosives Schneiden 456
	9.2.4	Anwendungsbeispiele 459
	9.3	Präzisionselektrochemische Mikrobearbeitung (von R. Förster) 461
	9.3.1	Vorgänge im Bearbeitungsspalt 462
	9.3.1.1	Spannungsabfall 462
	9.3.1.2	Anodische Metallauflösung 464
	9.3.2	Elektrolytlösungen 466
	9.3.2.1	Kenngrößen der Elektrolytlösungen 468
	9.3.3	Untersuchungen verschiedener Werkstoffe 469
	9.3.3.1	Eisen, Eisenlegierungen und Stähle 469
	9.3.3.2	Titan und Titanlegierungen 470
	9.3.3.3	Hartmetalle 470
	9.3.4	ECM-Senken mit oszillierender Werkzeugelektrode 471
	9.3.4.1	Prozesskenngrößen 471

z

9.3.4.2	Darstellung der Vorgänge im Arbeitsspalt 472
9.3.4.3	Werkzeugelektrodenwerkstoffe 473
9.3.5	Elektrochemische Bearbeitungsverfahren in der Mikro-
	systemtechnik 474
9.3.5.1	Elektrochemisches Mikrobohren 474
9.3.5.2	Elektrochemisches Mikrodrahtschneiden 474
9.3.5.3	Elektrochemisches Mikrofräsen 475
9.3.5.4	Weitere Anwendungsbeispiele des Verfahrens in der Mikro-
	systemtechnik 476
9.4	Replikationstechniken 478
9.4.1	Spritzgießen 478
9.4.2	Heißprägen 480
9.5	Laserunterstützte Verfahren 482
10	Aufbau- und Verbindungstechniken 485
10.1	Hybridtechniken 486
10.1.1	Substrate und Pasten 486
10.1.2	Schichterzeugung 489
10.1.2.1	Trocknen und Einbrennen der Pasten 490
10.1.3	Bestücken und Löten der Schaltung 490
10.1.4	Montage und Kontaktierung ungehäuster Halbleiter-
	bauelemente 493
10.2	Drahtbondtechniken 493
10.2.1	Thermokompressionsdrahtbonden (Warmpressschweißen) 494
10.2.2	Ultraschalldrahtbonden (Ultraschallschweißen) 495
10.2.3	Thermosonicdrahtbonden (Ultraschallwarmschweißen) 495
10.2.4	Ball-Wedge-Bonden (Kugel-Keil-Schweißen) 496
10.2.5	Wedge-Wedge-Bonden (Keil-Keil-Schweißen) 497
10.2.6	Vor- und Nachteile der einzelnen Drahtbondverfahren 498
10.2.7	Prüfverfahren und Alternativen 499
10.3	Alternative Kontaktierungstechniken 500
10.3.1	TAB-Technik 500
10.3.2	Flip-Chip-Technik 501
10.3.3	Entwicklung neuer Kontaktierungssysteme 503
10.4	Kleben 503
10.4.1	Isotropes Kleben 504
10.4.2	Anisotropes Kleben 505
10.5	
	Anodisches Bonden 507
11	Anodisches Bonden 507 Systemtechnik 511
11 11.1	
	Systemtechnik 511
11.1	Systemtechnik 511 Definition eines Mikrosystems 511
11.1 11.2	Systemtechnik 511 Definition eines Mikrosystems 511 Sensoren 513 Aktoren 517 Signalverarbeitung 519
11.1 11.2 11.3	Systemtechnik 511 Definition eines Mikrosystems 511 Sensoren 513 Aktoren 517

XIV	Inhalt	
	11.4.2	Neuronale Datenverarbeitung für Sensorarrays 523
	11.5	Schnittstellen eines Mikrosystems 528
	11.5.1	IE-Übertragung 531
	11.5.1.1	Elektrische Mikro-/Makroankopplungen 531
	11.5.1.2	Optische Mikro-/Makroankopplungen 533
	11.5.1.3	Lichtwellenleiter-Ankopplungen 533
	11.5.1.4	Mechanische Mikro-/Makroankopplungen 533
	11.5.1.5	Ultraschallübertragung 534
	11.5.2	S-Übertragung 535
	11.5.2.1	Fluidische Mikro-/Makroankopplungen 535
	11.5.2.2	Fluidische Mikrokomponenten 535
	11.6	Entwurf, Simulation und Test von Mikrosystemen 537
	11.7	Modulkonzept der Mikrosystemtechnik 540

Literatur 545

Stichwortverzeichnis 565